



Littelfuse®

Forschungs- und Entwicklungsingenieur (w/m/d) IGBT Lampertheim

Als Mitarbeiter im High Power IGBT R&D-Team sind Sie für die Entwicklung von Hochspannungs-Silizium-Leistungsbauerelementen für unser High Power IGBT-Modulportfolio verantwortlich.

Über die Position:

- Design und technologische Entwicklung von Hochspannungs-Silizium-Leistungsbauerelementen der nächsten Generation
- Generieren von neuen Ideen für Gerätestrukturen und Herstellungsverfahren und Bewertung dieser durch Analyse des Versuchsdesigns
- Zusammenarbeit mit Wafer-Foundry-Partnern, zur Erreichung der Produktionsreife der neuen Designs und Prozesse

Über Sie:

- Ingenieurstitel oder Masterabschluss im Halbleiterbereich (PhD wäre wünschenswert)
- Vorerfahrung im Bereich Halbleiter, IGBT und MOSFET
- Einschlägige Erfahrung bei der Datenanalyse und im Umgang mit TCAD
- Kenntnisse gängiger Programmiersprachen
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Littelfuse ist bestrebt, das Wachstum und die Entwicklung der Mitarbeiter, in einer Kultur der kontinuierlichen Zusammenarbeit und des Respekts für unterschiedliche globale Perspektiven und Fachkenntnisse, zu fördern. Unsere Kernwerte – Kundenorientierung, Integrität, Innovation, Teamarbeit und Ergebnisorientierung – unterstützen uns bei unserer Mission, die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung der Produkte und Systeme unserer Kunden zu verbessern.

Wir sind ein Arbeitgeber für Chancengleichheit, der stolz darauf ist, jedem Mitarbeiter die Mittel und den Mut zu geben, etwas zu bewegen – überall, jeden Tag. Wir bieten ein konkurrenzfähiges Gehaltspaket und eine Vielzahl von Zusatzleistungen, darunter Homeoffice, flexible Arbeitszeiten sowie Entwicklungsmöglichkeiten wie die interne Lean Six Sigma-Zertifizierung.

If you are interested in this position, please reach out to Diandra Roth (droth@littelfuse.com)